Accounts of Materials & Surface Research

Activation and spillover of hydrogen on the model catalysts functionalized by Pd deposition

Wataru Osada, Fumihiko Ozaki, Shunsuke Tanaka, Jun Yoshinobu*

The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo 5-1-5, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8581, Japan junyoshi@issp.u-tokyo.ac.jp

Palladium is a unique metal that can dissociate molecular hydrogen, adsorb and absorb atomic hydrogen, and it also plays an important role as homogeneous and heterogeneous catalysts. By depositing Pd atoms on inert but more selective or electronically interesting solid surfaces, the functionalized surfaces can be tailored. In this account, we report our recent studies about the interaction between hydrogen and Pd-deposited Cu(111) and MoS_2 basal surfaces.

Keywords: Palladium, Hydrogen, Adsorption, Spillover

Wataru Osada received his Ph.D in Chemistry from the University of Tokyo under the direction of Prof. Jun Yoshinobu in 2022. He then works as a project researcher in the same group. His current research interest focuses on surface chemistry regarding CO₂-recycling on metal surfaces.

Fumihiko Ozaki received M.Sc degree in 2022 from the University of Tokyo under the direction of Prof. Jun Yoshinobu. He is now a Ph.D student at Department of Advanced Material Science under the supervisor of Prof. Jun Yoshinobu. His research interest is surface properties and reactions of functionalized 2D materials.

Shunsuke Tanaka received his Ph.D. degree under the supervision of Prof. Kazuya Watanabe at Kyoto University in 2017. He then worked as a postdoctoral researcher in Prof. Kato's group at RIKEN. In 2019, he joined Prof. Yoshinobu's group as a research associate. His current research interest focuses on catalytic reactions on two-dimensional materials and surface nonlinear spectroscopy.

Jun Yoshinobu received his doctoral degree from Kyoto University under the supervision of Prof. M. Onchi and Prof. M. Nishijima in 1989. After a postdoctoral fellow for Prof. J. T. Yates, Jr., at Univ. of Pittsburgh, he joined RIKEN as a special postdoctoral researcher at Surface and Interface Engineering Laboratory supervised by Dr. M. Aono in 1991 and later moved as a researcher to Surface Chemistry Laboratory supervised by Dr. M. Kawai. In 1997, he got an associate professor position at The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo and promoted as a professor in 2007. His research interest covers a wide range of surface science including Si surface chemistry, kinetics and dynamics of atoms/molecules on well-defined surfaces and model catalysts.









パラジウム蒸着により機能化したモデル触媒表面における 水素の活性化とスピルオーバー

長田 渉, 尾崎 文彦, 田中 駿介, 吉信 淳 東京大学 物性研究所

1. 緒言

1-1 パラジウムの特性と触媒機能

原子番号46のパラジウム(Pd)は、第5周期10 族の 4d 遷移金属であり、白金族に属する。常 圧、常温で安定な結晶構造は面心立方構造 (fcc)である。耐食性と、ある程度の柔らかさをも つので、合金としても利用されている。身の回り では、Pd合金は歯科治療の詰め物や宝飾用貴 金属として利用されている。工業的にはPdは現 代社会にとって不可欠な金属である。例えば、 ガソリン自動車の排気ガス浄化を目的とした三 元触媒(three way catalyst)、アセチレンの水 素化触媒、エチレンと酸素からアセトアルデヒド を生成する触媒として、Pd を含む触媒が利用さ れている [1-3]。 有機合成化学においても古く から Pd が触媒として利用されてきた[4,5]。特に 炭素・炭素結合を生成するクロスカップリング反 応で Pd が均一系触媒として重要な役割をはた している[6-8]。2010年には、「有機合成におけ るパラジウム触媒クロスカップリング反応」に大き な貢献をしたリチャード・ヘック、根岸英一、鈴木 章に対してノーベル化学賞が授与された[9]。こ のように Pd は、様々な均一系および不均一系 触媒として重要な金属である。

1-2 パラジウムと水素との相互作用

最近、エネルギーキャリアーとして注目を集め ている水素を利用するためには、水素の貯蔵や 水素の精製が不可欠である。Pd は常温で体積 の約 900 倍の水素分子を吸収することが知られ ている。また、Pd および Pd 合金膜は、水素を 透過させることができるので、水素ガスの純化の ために利用されている。遷移金属の中でバルク 内部への水素吸収が発熱反応である純金属は Pd だけである[10-12]。水素が Pd バルク内へ 吸収されるためには、Pd 表面での水素分子の 解離吸着、水素原子の表面吸着サイト(S)から サブサーフェス・サイト(SS)およびバルク(B)へ の拡散が必要となる。図 1(a)に、Pd と水素の相 互作用についての1次元ポテンシャルエネルギ ーを描いた。Pd の場合、解離の活性化障壁が 無く、表面に原子として解離吸着する。吸着エ ンタルピー変化 ΔHad は表面構造および吸着サ イトに依存する。ΔHab は吸蔵エンタルピー変化、 ΔEdif はバルク内部の拡散の活性化エネルギー を示す。一方、水素分子の解離反応の活性化 障壁が高い(つまり解離活性が低い)金属のポ テンシャルエネルギー図を図 1(b)に示す。銅 (Cu)がこの場合に相当し、銅表面で水素分子 が室温で解離吸着する確率は極めて小さい。し かし、原子状水素に銅表面を曝露すると、水素 原子は銅表面に発熱的に吸着することができる。 銅の場合はバルク内への吸収は吸熱的である ので、水素原子が拡散してバルク内部に吸収さ れることはない。

2章で紹介するように、銅表面にPd原子を少 量蒸着し単原子合金を作製した場合のポテン シャルエネルギー図を図 1(c)に示す。表面に 衝突した水素分子のうち Pd サイトでは解離吸 着するが、Cu サイトでは跳ね返される。しかし、 Pd サイトで解離吸着した水素は表面を拡散し、 Cu サイトにスピルオーバーすることができる。

本解説では、真空中で Pd を蒸着した2つの モデル触媒表面(Cu 表面と MoS₂表面)と水素 との相互作用について、最近の我々の研究を 紹介したい[14,15]。



Figure 1. (a) Potential energy diagram for dissociative adsorption and absorption of hydrogen with a negligible dissociation barrier such as Pd. ΔH_{ad} : enthalpy change for hydrogen adsorption, ΔH_{ab} : enthalpy change for hydrogen absorption, ΔE_{dif} : activation barrier for bulk diffusion. (b) Potential energy diagram for dissociative adsorption of hydrogen with a high dissociation barrier (for example, Cu surface) (c) Potential energy diagram of dissociative adsorption and absorption of hydrogen at the Pd and Cu sites on a single atom alloy Pd/Cu surface.

2. Pd/Cu 単原子合金触媒

2-1 単原子合金触媒(SAAC)

近年、単原子合金触媒(Single Atom Alloy

Catalyst, SAAC) が高活性かつ高選択率な触媒 として注目を集めている。SAAC 研究のパイオ ニアである Sykes らのグループによると、SAAC とは「金属表面に少量の異種金属が原子状に 分散することで単原子サイトを形成している二元 合金不均一触媒」と定義される[16]。

基板金属としては銅や金などの不活性な金 属元素、単原子サイトとなる添加金属としては Pd や Pt など触媒活性の高い金属が選ばれる ことが多い。Pd や Pt は Cu 表面において SAAC を形成しやすいことが密度汎関数理論 (DFT)に基づく表面偏析エネルギーおよび凝 集エネルギー計算によって示された[17]。

Cu(111)表面における Pd の合金化プロセス が、走査型トンネル顕微鏡(STM)などの手法 によって研究された[18-20]。Aaen らは、室温 で Pd を Cu 表面に蒸着すると、ステップ近傍で Pd 原子が Cu 原子を置換する形で単原子とし て分散することを報告した [18]。また、523 Kに 加熱することで一部の Pd 原子がサブサーフェ スに移動することを観測した[18]。Sykes らの研 究グループは STM 観測と DFT 計算との組み 合わせによる合金化プロセスのモデル提案(図 2)[19]、走査トンネル分光による単原子 Pdの電 子状態観測[20]、Cu 表面へスピルオーバーし た原子状水素の STM 観測[21]などの研究を報 告した。

SAAC を活用した触媒反応は 2012 年に報告された。Pd/Cu(111)表面($\theta_{Pd}=0.01$ ML)において、不飽和炭化水素の部分水素化反応が高選択率で進行することが昇温脱離質量分析(TPD)により示された[22]。表面に島状 Pd が存在するときには炭化水素の分解が進行し、部分水素化生成物への選択率が大きく低下することも同時に報告され、SAAC が従来の表面合金とは異なる特異な触媒特性を持つことが示された。

2-2 Pd/Cu(111)と水素との相互作用

SAAC における高選択的水素化反応は、触 媒表面の二つの機能によって説明されることが 多い。すなわち、単原子 Pd サイトは水素分子の 解離サイトとして働き、Cu サイトは吸着分子の 水素化サイトとして働く。Cu 表面は分子との相 互作用が弱く水素化された分子がただちに脱 離するため、部分水素化反応が高選択率で進 行すると考えられている。このような反応機構モ デルにおいては、Pd サイトから Cu サイトへの水 素のスピルオーバーは重要な素過程のひとつ である。それにも拘らず、Pd/Cu SAAC 表面に おける水素の吸着についての実験的報告例は STM および TPD だけであった[21-24]。我々 は、赤外反射吸収分光(IRAS)、TPD、放射光 を利用した高分解能 X 線光電子分光(HR-XPS)、第一原理計算を複合化して解析し、 Pd/Cu(111)表面における水素の解離とスピル



Figure 2. A schematic of hydrogen spillover process on a Pd/Cu surface.

オーバー過程について研究し、原子レベルでの描像を明らかにした[15]。

図 3 は、Pd/Cu(111)表面を約 80 K で 4.0 × 10⁻⁴ Pa の H₂ガスを導入しながら測定した時間 分解 IRAS の結果である。1143-1135 cm⁻¹ に 時間とともに成長するピークが検出され、H-Cu 結合に由来する振動ピークと帰属した[25,26]。 ピーク面積の時間的振る舞いを線形近似すると、 時間軸に約 260 秒の切片を持つ直線が得られ た。このことは H₂曝露の開始から約 260 秒遅れ て H-Cu の振動ピークが観測可能になったこと を示している。この遅延時間は、80 K という低温 では Pd サイトから Cu サイトへのスピルオーバ ーが遅い過程であることを示唆している(近似直 線の傾きから 1.4 × 10⁻⁴ ML s⁻¹と見積もった)。 すなわち、解離吸着によって生じた原子状水素 は 80 K ではしばらくの間 Pd サイトに留まり、少 しずつ Cu サイトへと移っていく。この結果は Pd サイトから Cu サイトへの水素のスピルオーバー を実時間観測した世界で初めての例である。

TPDでは水素の再結合脱離に由来する脱離 ピークが 220 K に観測された。対称的なスペク トル形状から、水素の脱離が二次の再結合脱離 機構によることを示唆している。一方で、脱離ピ ーク温度は水素の吸着量が増えても一定であ った。Wigner-Polanvi の式によれば、脱離の 活性化エネルギーが一定であれば、二次脱離 のピーク温度は初期吸着量の増加に伴い低温 側ヘシフトする。このことから、Pd/Cu(111)表面 においては、水素の吸着量の増加に伴い脱離 の活性化エネルギーが増大していると考えられ る。その結果として、水素吸着量が増えても、 TPD のピーク温度がほぼ一定になると考えられ る。これは気相の水素分子から見た場合、水素 の解離吸着が進むと、活性化障壁が増大して いることに相当する。

HR-XPS により、Pd 3d5/2 光電子スペクトル を観測し、内殻準位シフトに基づいて Pd と水 素との相互作用を調べた。図4に水素曝露に伴 う Pd 3d5/2 スペクトルの変化を示した。Cu(111) 表面に Pd を蒸着した後、約 80 K に冷却して から H₂ガス曝露を行った。10L、50L、800L と順次 H₂ガス曝露量を増やし、XPS 測定を行 った(1L=133×10⁻⁴ Pas)。最後に、曝露後の 表面を150Kに加熱した状態で測定した。一連 のスペクトルで 335.3, 335.7, および 336.4 eV にピークが観測された。335.3 eV のピークは清 浄な SAAC 表面の Pd 原子と帰属される。Pd 3d5/2 光電子ピークは Pd(111) 清浄表面で 334.6-334.7 eV、Pd-Cu 合金表面で 335.82 eV と報告 されている[27-29]。Pd/Cu(111)ではそれらの中 間的な値であり、SAAC では純金属ともバルク 合金とも異なる特徴的な電子状態となってい ることが分かる。335.7 eV と 336.4 eV はどち



Figure 3. (a) Time-resolved IRAS spectra during H₂ exposure onto the Pd/Cu(111) surface (θ_{Pd} = ~0.01 ML). The indicated time, *t*, is the elapsed time from the start of H₂ dosing. The inset shows the spectrum at 2129 s in the CO region. (b) The change of the hydrogen coverage as a function of elapsed time. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies.

らも水素曝露によって生じる成分であるが、ピ ーク強度の振る舞いを見ると335.7 eV は 50 L 曝露で極大を示す一方で、336.4 eV は 800 L まで単調に増加している。この振る舞いから、水 素の吸着量が少ないときには 335.7 eV にピー クを示し、水素の吸着量が増えていくと 336.4 eV にピークが観測されると解釈した。

第一原理計算に基づいて、Pd/Cu(111)表面 への水素原子吸着と水素吸着に伴う電子状態 変化について述べる。OpenMX コードを使用し、 様々な吸着構造モデルに対し吸着エネルギー とPd 3d5/2 束縛エネルギーの DFT 計算を行っ た。図5にDFT 計算に用いた吸着構造モデル を水素原子一つあたりの吸着エネルギーととも に示した。吸着エネルギーから、水素原子が三 つ以下のときは Pd 原子を含む hcp ホローサイ トのみを水素が占有する構造が安定であること が分かる。また、水素原子が四つのときは、水素 をすべて Pd サイトに配置するよりも、一つを Cu サイトに配置した方が安定である。さらに、構造



Figure 4. HR-XPS results measured on the Pd/Cu(111) surface (θ_{Pd} = 0.08 ML). (a) A series of Pd 3d_{5/2} spectra measured on the clean and H₂-exposed Pd/Cu(111) surface. (b) The change in the normalized intensity of each fitting component as a function of the experimental process. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies.

(j)-(l)を比べてみると、水素が Pd サイトから離 れるほどエネルギーが低くなり安定化してい くことが分かる。これは、エンタルピー的な駆 動力によって水素のスピルオーバーが促進さ れることを示唆する結果である。もちろん、エ ントロピーによってもスピルオーバーが促進 されることが先行研究によって示されている [30]。

表1にPd 3d_{5/2}束縛エネルギーの計算結果 を示した。図5 に示した構造モデルに加え、水 素の数を増やした構造(図6)に対する計算結 果も含めた。水素の数が増えるにつれて、束縛 エネルギーが系統的に大きくなっていくことが分 かる。Pd サイトに二つの水素原子が吸着したと きの束縛エネルギーは、清浄表面よりも0.4 eV 大きく、実験における一段階目の化学シフトとよ く一致する。さらに、Pd/Cu(111)表面の全ての hcp ホローサイトに水素を吸着させた構造では 清浄表面との束縛エネルギーの差は0.9 eV で あり、実験の二段階目のシフト量と近い。このよ

https://www.hyomen.org

うに、実験で観測された Pd 3d5/2の二段階の化 学シフトは水素の吸着量を反映したものである ことが理論的にも裏付けられた。

ここで興味深いことに、Pd の最近接サイトに 三つの水素原子が吸着した後、Cu 表面にさら に水素が吸着することに伴い、Pdの電子状態が 変化する点である。例えば、3H-hcp、4H-far、 5H および1MLHの構造をそれぞれ比べてみ



Figure 5. Structural models of the clean and H-adsorbed Pd/Cu(111) surfaces used in DFT calculations. The orange, gray, and small white spheres present the Cu, Pd, and H atoms, respectively. The indicated values below each model are the adsorption energies per one H atom. 0 eV was defined as an energy level of gaseous H₂ molecules. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies.





Figure 6. Structure models of the Pd/Cu(111) surface used in DFT calculations for the corelevel excitation. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies. ると、Pd 原子に直接吸着している水素の数はいずれも三つであり、水素とPd の相互作用という 観点からはこれらの構造はよく似た束縛エネル

Table 1. The calculated binding energies (CBEs) of Pd $3d_{5/2}$. The configurations in the first column correspond to those in Figures 5 and 6. Δ CBE in the last column is the difference of the CBE from the clean surface. The asterisk marks represent the stable structures. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies.

Configuration	Binding energy /	ΔCBE /
	eV	eV
clean	335.7	0
1H-hcp*	335.9	0.2
2H-2NN*	336.1	0.4
2H-3NN	336.1	0.4
2H-Pd&Cu	335.9	0.2
3H-hcp*	336.2	0.5
3H-Pd&Cu	336.1	0.4
4H-all hollow	336.5	0.8
4H-hcp⊤	336.8	1.1
4H-near	336.2	0.5
4H-middle	336.3	0.6
4H-far*	336.3	0.6
5H	336.4	0.7
1 ML H	336.6 0.9	

ギー値を示すと予想できる。しかし、DFT 計算 によるとPd 3d_{5/2}束縛エネルギーは水素の総数 が多いほど大きくなる。Pd 原子への水素原子吸 着が3個で飽和したのちに、Cu 表面に水素原 子が吸着することに伴う Pd の電子状態の起源 については、マリケン電荷密度から理解すること ができる。

表2に、上から中性原子、清浄 Pd/Cu(111)表 面および水素吸着 Pd/Cu(111)表面の順に、水 素、Pd、Cu 原子それぞれのマリケン電荷密度 を示した。水素は全吸着水素原子の平均値、 Cu は Pd 周辺の6原子の平均値を示した。ま

ず、水素の電荷密度を見ると、吸着水素原子は中性原子状態よりも電荷が大きく、3H-hcp構

造、1 ML H 構造のどちらにおいても吸着水素 原子は Pd/Cu 表面から電子を奪っていることが

Table 2. Mulliken charge populations in H, Pd,and Cu atoms. Copyright: Reproduced fromref. 15 with permission from the PCCP OwnerSocieties.

Configuration	Mulliken charge		
	Н	Pd	Cu
Neutral atom	1	16	19
clean	-	15.86	19.12
3H-hcp	1.17	15.80	19.11
1 ML H	1.12	15.74	19.10

(i) (ii) (ii)



Figure 7. The atomic-level view of the hydrogen dissociation and spillover processes on the Pd/Cu SAAC surface. (i) A H₂ molecule is approaching a Pd site; (ii) Two dissociated H atoms are adsorbed on two hcp-hollow site involving the Pd atom; (iii) Three H atoms are adsorbed on three hcp-hollow site involving the Pd atom, and the fourth H atom is adsorbed on a Cu site; (iv) The hydrogen spillover occurs after the Pd sites are saturated by H atoms. Reproduced from ref. 15 with permission from the PCCP Owner Societies.

分かる。次に、Pd の電荷密度について見てみ ると、Pd/Cu 合金表面の Pd 原子は中性原子状 態より電荷が減少している。このことは、Pd/Cu 合金表面において Pd 原子から Cu 原子への電 荷移動が起きていることを示唆している。これは 先行研究の STM による微分コンダクタンス測定 [20]や、図 4 の XPS 測定の結果と定性的に一 致する。さらに、水素原子が Pd/Cu 表面に吸着 すると Pd 原子はさらに電子を失う。ここで、3H- hcpと1 MLHのPd 原子の電荷密度を比べて みると、Pd サイト上の水素原子の数は同じであ るにも拘らず、1 ML H のとき、Pd 原子はより電 子を失っている。これは HR-XPS で観測された 水素原子吸着による Pd 原子の束縛エネルギー 変化と対応している。つまり、Cu 表面に水素吸 着することで Pd 原子の電荷密度が減少してお り、これが Pd 3d5/2の 1.2 eVもの高エネルギー シフトの起源であると考えられる。最後に、Cu表 面における電荷密度変化に注目してみる。清 浄表面(clean)と水素吸着表面(3H-hcp, 1ML H)を比べると、水素原子は吸着により電荷密度 が上昇していたのに対し、Cu 原子の電荷密度 はわずかしか変化していない。このことは水素 原子の電荷密度上昇は、他の原子によるもので あることを意味する。Pd 原子の束縛エネルギー シフトの起源として議論したように、Cu サイト上 の水素原子が吸着すると、Pd の電荷密度が減 少する。

以上のマリケン電荷の議論から、Pdから水素 への直接の電荷移動に加えて、Cu原子を介し た間接的な電荷移動が起こっていると解釈でき る。このような直接・間接的な電荷移動の結果、 Pd 3d5/2 束縛エネルギーの二段階の化学シフト が観測されたと考えられる。

以上の結果をまとめると、Pd/Cu(111)におけ る水素の解離吸着とスピルオーバー過程は、図 7 にまとめたような描像で進行すると考えられる。 すなわち、(i)表面に近づいてきた水素分子がま ず Pd サイトで解離する。(ii)生じた二つの水素 原子は、Pd 原子を含む hcp ホローサイトをひと つずつ占有する。(iii)3 つの hcp サイトが占有さ れると、(iv)その後はエンタルピー(とエントロピ ー)を駆動力として Cu サイトにスピルオーバー していく。

3. Pd による MoS₂ 基底面の機能化 3-1 MoS₂の触媒作用

二硫化モリブデン MoS₂は、グラフェンと同様、 2 次元材料として利用できることから幅広い応用 のために注目を集めている[31]。現在では、電 界効果トランジスター[32]や光電子デバイス [33]、ケミカルセンサー[34]などの多くの分野に おける研究対象になっているが、古くから触媒と して利用されてきた[35]。代表的なものが水素 化脱硫触媒であり[36]、原油に含まれる有機硫 黄化合物中の C-S 結合を切断し、硫黄を取り除 くことで、クリーンな燃料を作り出すことができる。 現在も工業的に利用されており、ガソリンや軽油 のサルファーフリー化に大きく貢献している。以 上を背景として、MoS₂の基礎的な表面科学研 究が半世紀以上にわたり行われてきた[37]。

MoS₂表面は、ファンデルワールス結合によっ て積層している基底面と、その垂直方向のエッ ジ面に大別できる(図 8)。理想的な基底面は、 S原子で終端されているためにダングリングボン ドのようなものはなく、不活性であることが良く知 られている。一方で、配位不飽和な状態として



存在しているエッジ面が活性サイトとして働く [35]。しかし、MoS2における表面積の大部分は 基底面が占めていることから、この基底面を反 応場として活用することができれば、触媒能のさ らなる向上につながると考えられている。

最近では、水素化脱硫触媒だけでなく、水分 解による水素発生触媒[38]や CO₂の水素化触 媒[39]としても期待されていることから、水素分 子に対して活性な表面を作製することは重要で あるといえる。前述の通り、水素解離能を有する Pd は MoS₂ 基底面の活性サイト形成のために 適しており、我々は MoS₂ 基底面に Pd を蒸着 することで機能化を狙った。

3-2 Pd-MoS₂基底面と水素

MoS₂ 基底面の機能化を目的に、Pd を蒸着 した MoS2 表面と水素との相互作用について雰 囲気 X 線光電子分光(AP-XPS)を用いて調べ た。通常の光電子分光は高真空中から超高真 空で測定を行うが、AP-XPS はアナライザーを 差動排気によって高真空に維持することで、サ ンプル周りは気体雰囲気中での測定が可能に なる[40]。光電子分光は、固体表面及び気体原 子・分子の電子状態を観測することができるた め、固体表面と気体分子との相互作用を調べる ために有用な分析手法である。実際に、使用し た装置は SPring-8 BL07LSU に設置された、 反応セルを持つ雰囲気光電子分光装置である [41]。超高真空(UHV)に保たれた準備チェン バーで MoS2 単結晶の基底面に Pd を蒸着し、 サンプルを測定チェンバーのセルに移送した。 セル内に UHV から最大 12.6 mbar まで水素 を導入し、この一連の過程を AP-XPS で観測し た。

まず、Pd 蒸着していない MoS2では、室温で



Figure 9. (a) Mo 3d_{5/2}, (b) S 2p, (c) valence-band, and (d) Pd 3d_{5/2} spectra of the Pd/MoS₂ as a function of H₂ gas pressure. The amount of deposited Pd was estimated to be 2.0 % for the amount of Mo atoms on the outermost MoS₂ layer. After the cell pressure increased up to 12.6 mbar, hydrogen gas was evacuated to 0.3 mbar. (e) The upper and lower figure are the fitting results for the Pd 3d_{5/2} AP-XPS spectra before and after the hydrogen exposure, respectively. The green component and blue component in the lower figure are assigned to be surface and bulk components of the Pd islands, while the pink component would consist of the bulk component and hydrogen atoms-adsorbed surface component. (f) The relative energy shifts for the Mo 3d_{5/2} core-level, S 2p_{3/2} core-level, and VBM. Reprinted from ref. 14, Copyright 2022 Published by Elsevier B.V., with permission from Elsevier.

水素導入しても XPS スペクトルにほとんど変化 は観測されなかった。これは、MoS2基底面が室 温では不活性であることを示している。次に、Pd 蒸着した MoS2表面に対して AP-XPS 測定を 行った。図 9(a)-(d)は、Mo 3d および S 2p、価 電子帯、Pd 3d のスペクトルの水素圧力変化を 示している。さらに、ブロードな Pd 3d スペクトル の詳細を議論するために、水素導入前後の Pd 3d スペクトルに対してフィッティング解析を行っ た(図 9(e))。水素導入前では、2 成分に分解さ れ、低結合エネルギー側が Pd の表面成分、高 結合エネルギー側が Pd のバルク成分と帰属す ることができる。一方で、水素導入後には、Pd Acc. Mater. Surf. Res. 2023, Vol.8 No.3, 147-158. 3d スペクトルは 1 成分でフィッティングできた。 これは、Pd-H 結合によって低結合エネルギー 側の表面 Pd 成分が高結合エネルギー側に化 学シフトしたためである。つまり、MoS₂ 表面の Pd サイトで、水素分子が解離吸着していること が示唆される。図 9(f)は、Mo 3d、S 2p、価電子 帯最大値のピーク位置をプロットしたもので、エ ラーバーはプロット点のサイズ以下である。水素 を導入していくと一様な低結合エネルギーシフ トが見られ、0.1 eV 程度のシフトが観測された。 この変化は表面に Pd 蒸着していない MoS₂と は明らかに異なる振る舞いであり、内殻から価

電子帯におけるすべての XPS ピークで系統的 な低結合エネルギーシフトを示していることから、 MoS₂ 表面でバンドベンディングが生じていると 解釈した。そのシフト方向から上向きのベンディ ングであることがわかる。これは MoS2 表面から 吸着した水素原子誘起準位への電子移動によ って伝導帯の電子数の減少が起きたことに起因 すると考えられる[42]。実際に、超高真空下で の原子状水素吸着実験では、水素吸着によっ て MoS₂ 表面が上向きのバンドベンディングを 示すことが観測されていることからも[14]、この バンドベンディングは水素吸着によるものである ことが支持される。つまり、水素分子は MoS2 表 面の Pd サイトを経由して水素原子として拡散さ れることで、MoS2 表面に水素が吸着される。こ のとき、理論的な吸着安定性を考慮すると[43]、 水素原子は最表面の S 原子に吸着し、S-H 結 合を形成することが考えられる。これらの結果か ら、MoS2基底面にPdを蒸着することにより、Pd サイトで水素分子が解離吸着し、MoS2表面へ の水素原子のスピルオーバーが生じることが示



Figure 10. Schematic model of hydrogen spillover on Pd-MoS₂. Reprinted from ref. 14, Copyright 2022 Published by Elsevier B.V., with permission from Elsevier.

唆される(図 10)。このような手法による MoS₂基 底面の機能化により、触媒能の向上やガスセン サー応用への展開が期待される。

4. 結言

本稿では、モデル触媒表面としてよく規定され た Cu(111)清浄表面および MoS₂ 基底面を超 高真空中で準備し、少量の Pd を蒸着すること により水素解離活性という新たな機能を付加し た表面における水素の解離吸着とスピルオーバ ーについて、我々の基礎的研究を中心に紹介 した。合金表面の触媒作用については古くから 研究されて来たが [44,45]、最近は単原子合金 触媒[16,46]をはじめ、金属間化合物[47,48]な どの研究が活発である。これは、放射光分光や 走査透過電子顕微鏡のように元素や原子を特 定して活性サイトやその電子状態を直接観測す る実験手法が進歩したこと、および、第一原理 計算による触媒反応の計算シミュレーションが 飛躍的に進んだことが背景にある。これからは、 データ科学を応用した触媒の探索[49,50]と実 験的研究が両輪となり、触媒機能が原子レベル で解明され、新触媒の発見と開発が進むことを 期待したい。

5. 謝辞

本稿で紹介した内容は、主に文献 14 および 15 によるものであり、共同研究者の皆様に深く 感謝する。DFT 計算では、尾崎泰助教授、河 村光晶博士に多くのご助力を頂いた。AP-XPS 実験は、堀尾眞史博士、小板谷貴典博士、山 本達博士、松田巖教授のご協力のもと行われた。 これらの研究は、新学術領域「ハイドロジェノミク ス」(JP18H05517)、科学研究費基盤 A (20H00343)、JST-CREST(JPMJCR20R4) などの研究助成により支援された。放射光実験 は、KEK-PFの課題(2020G619, 2018S2-005) および SPring-8 の課題(2020A7481, 2021A7426)として採択され、遂行された。

参考文献

- L. Lloyd, "Handbook of Industrial Catalysts", Springer, 2011.
- P. Prins, A. Wang and X. Li, "Introduction to Heterogeneous Catalysis" World Scientific, 2016, Singapore.
- J. Wang, H. Chen, Z. Hu, M. Yao and Y. Li, Catal. Rev., 2015, 57, 79-144.
- J. Tsuji, Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis., Wiley, Chichester, UK, 1997.
- 5) 辻二郎、「有機合成のための遷移金属触媒 反応」東京化学同人、2008.
- N. Miyaura and A. Suzuki, *Chem. Rev.*, **1995**, 95, 2457-2483.
- 7) C. Amatore and A. Jutand, J. Organomet. Chem., **1999**, 576, 254-278.
- A. Biffis, P. Centomo, A. Del Zotto, and M. Zecca, *Chem. Rev.*, 2018, *118*, 2249-2295.
- 9) <u>https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry</u> /2010/summary/および,宮浦憲夫, 学術の 動向, 2011, 5, 13-17.
- 20) 深井有,田中一秀,内田裕久,「金属と水 素」,内田老鶴圃,1998.
- 11) 有賀哲也, 表面科学, 2006, 27, 341-347.
- 12) K. Christmann, *Surf. Sci. Rep.*, **1988**, *9*, 1-163.
- K. Fukutani, J. Yoshinobu, M. Yamauchi, T. Shima and S. Orimo, *Catal. Lett.*, **2022**, *152*, 1583-1597.
- 14) F. Ozaki, S. Tanaka, W. Osada, K. Mukai, M. Horio, T. Koitaya, S. Yamamoto, I. Matsuda and J. Yoshinobu, *Appl. Surf. Sci.*, **2022**, *593*, 153313.
- 15) W. Osada, S. Tanaka, K. Mukai, M. Kawamura, Y.H. Choi, F. Ozaki, T. Ozaki, J. Yoshinobu, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2022, 24, 21705.
- 16) R. T. Hannagan, G. Giannakakis, M. Flytzani-Stephanopoulos, E. C. H. Sykes, *Chem. Rev.*,

2020, *120*, 12044.

- 17) M. T. Darby, E. C. H. Sykes, A. Michaelides and M. Stamatakis, *Top. Catal.*, **2018**, *61*, 428.
- A. Bach Aaen, E. Lægsgaard, A. V. Ruban and I. Stensgaard, *Surf. Sci.*, **1998**, *408*, 43.
- 19) D. O. Bellisario, J. W. Han, H. L. Tierney, A. E. Baber, D. S. Sholl and E. C. H. Sykes, *J. Phys. Chem. C*, **2009**, *113*, 12863.
- 20) H. L. Tierney, A. E. Baber and E. C. H. Sykes, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 7246.
- 21) H. L. Tierney, A. E. Baber, J. R. Kitchin and E.
 C. H. Sykes, *Phys. Rev. Lett.*, 2009, 103, 246102.
- 22) G. Kyriakou, M. B. Boucher, A. D. Jewell, E. A. Lewis, T. J. Lawton, A. E. Baber, H. L. Tierney, M. Flytzani-stephanopoulos and E. C. H. Sykes, *Science*, 2012, *335*, 1209.
- 23)A. E. Baber, H. L. Tierney, T. J. Lawton and E. C. H. Sykes, *ChemCatChem*, **2011**, *3*, 607.
- 24)M. B. Boucher, B. Zugic, G. Cladaras, J. Kammert, M. D. Marcinkowski, T. J. Lawton, E. C. H. Sykes and M. Flytzani-Stephanopoulos, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2013, 15, 12187.
- 25) K. Mudiyanselage, Y. Yang, F. M. Hoffmann, O. J. Furlong, J. Hrbek, M. G. White, P. Liu and D. J. Stacchiola, *J. Chem. Phys.*, **2013**, *139*, 044712.
- 26) E. M. Mccash, S. F. Parker, J. Pritchard and M. A. Chesters, *Surf. Sci.*, **1989**, *215*, 363.
- 27) S. Surnev, M. Sock, M. G. Ramsey, P. P. Netzer, M. Wiklund, M. Borg and J. N. Andersen, *Surf. Sci.*, **2000**, *470*, 171.
- 28) M. J. Gladys, A. A. El Zein, A. Mikkelsen, J. N. Andersen and G. Held, *Surf. Sci.*, **2008**, *602*, 3540.
- 29) J. Tang, S. Yamamoto, T. Koitaya, A. Yoshigoe,
 T. Tokunaga, K. Mukai, I. Matsuda and J. Yoshinobu, *Appl. Surf. Sci.* 2019, 480, 419.
- 30) M. T. Darby, R. Réocreux, E. C. H. Sykes, A.

Michaelides and M. Stamatakis, *ACS Catal.*, **2018**, *8*, 5038.

- U. Krishnan, M. Kaur, K. Singh, M. Kumar and A. Kumar, *Superlattices Microstruct.*, 2019, 128, 274-297.
- 32) R. Ganatra and Q. Zhang, *ACS Nano*, **2014**, *8*, 4074-4099.
- 33) Q.H. Wang, K. Kalantar-Zadeh, A. Kis, J.N. Coleman and M.S. Strano, *Nat. Nanotech.*, 2012, 7, 699-712.
- 34) J. Theerthagiri, R.A. Senthil, B. Senthilkumar,
 A. Reddy Polu, J. Madhavan and Muthupandian Ashokkumar, J. Solid State Chem., 2017, 252, 43-71.
- 35) K.-I. Tanaka and T. Okuhara, J. Catal., 1982, 78, 155-164.
- 36) P. Li, Y. Chen, C. Zhang, B. Huang, X. Liu, T. Liu, Z. Jiang and C. Li, *Appl. Catal. A-Gen.*, 2017, 533, 99-108.
- 37) F. Besenbacher and J.V. Lauritsen, J. Catal.,2021, 403, 4-15.
- 38) Y. Cao, ACS Nano., 2021, 15, 11014-11039.
- 39) H. Li, L. Wang, Y. Dai, Z. Pu, Z. Lao, Y. Chen, M. Wang, X. Zheng, J. Zhu, W. Zhang, R. Si, C. Ma and J. Zeng, *Nat. Nanotech.*, **2018**, *13*, 411-417.
- 40) J. Schnadt, J. Knudsen and N. Johansson, J. *Phys.: Condens. Matter*, **2020**, *32*, 413003.
- 41) T. Koitaya, S. Yamamoto, Y. Shiozawa, K. Takeuchi, R.-Y. Liu, K. Mukai, S. Yoshimoto, K. Akikubo, I, Matsuda, J. Yoshinobu, *Top. Catal.*, 2016, *59*, 526-531.
- 42) Z. Zhang and J. T. Yates, Jr., *Chem. Rev.*, **2012**, *112*, 5520-5551.
- 43) D.C. Sorescu, D.S. Sholl and A. V. Cugini, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 239-249.
- 44) T. N. Rhodin and G. Ertl (ed.), The Nature of the Surface Chemical Bond (Elsevier, 1979).
- 45) J. Rodriguez, Surf. Sci. Rep., 1996, 24, 223-287.

- 46) S.Sovizi and R. Szoszkiewicz, *Surf. Sci. Rep.*, 2022, 77, 100567.
- 47) S. Furukawa and T. Komatsu, ACS Catal., 2017, 7, 735-765.
- 48) Y. Nakaya and S. Furukawa, *Chem. Rev.*, **2023**, 123, 5859–5947.
- 49) K. Takahashi, L. Takahashi, I. Miyazato, J. Fujima, Y. Tanaka, T. Uno, H. Satoh, K. Ohno, M. Nishida, K. Hirai, J. Ohyama, T. Nhat Nguyen, S. Nishimura, T. Taniike, *ChemCatChem*, 2019, *11*, 1146–1152.
- 50) Z. Yang and W. Gao, *Adv. Sci.* **2022**, *9*, 2106043.